

2014 年 12 月 10 日  
一般社団法人 新金属協会  
化合物半導体部会  
部会長 平野 立一  
J X 日鉱日石金属株式会社  
電材加工事業本部 薄膜材料事業部  
化合物半導体ユニット ユニット長

平成 26 年度上期の化合物半導体の出荷統計について

2014 年度上期（2014 年 4 月～2014 年 9 月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2014 年度上期（2014 年 4 月～2014 年 9 月）の化合物半導体製品の出荷額は、前年度比 105%の 157 億円となり、対前年度で 7 億円の増加となった。結晶別では、主要 3 品目のうち GaP、InP が増加し、GaAs が前年並みとなった。用途別では電子デバイスで落ち込んでおり、前年度比 82%となった。一方、可視 LED、赤外 LED 及び LD はそれぞれ前年度比 122%、116%、102%の伸びとなった。

#### 1.GaAs

2014 年度上期の GaAs の売上高は前年度並みとなった。地域別では輸出が前年同期比 108%と増加したのに対し、国内市場は同 81%と減少する結果となった。

GaAs の主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外 LED、および DVD 等に使用されるレーザダイオード（LD）等があるが、2014 年度上期は主に赤外 LED の伸びが GaAs 市場を牽引したものと推定している。

原料である Ga のロイター価格は足元、微減傾向となっている。

#### 2.GaP

2014 年度上期の GaP の売上高は前年度比 137%となった。国内、海外ともに回復した。しかしながら、安価で高輝度な中国製 AlInGaP 系 LED への置き換えの進行と GaP 系 LED および GaAsP 系 LED が車載、家電等の特定市場へ絞り込まれていく傾向は、今後も続くものと推察している。

### 3.InP

2014 年度上期の InP の売上高は前年度比 112%と増加した。InP の主要な用途は光通信用受発光素子である。スマートフォン等の情報端末、クラウドコンピューティング等の普及による通信量の増大を背景に、前年に引き続き光通信用部品の所要が堅調に推移した結果と推察している。

＜お問い合わせ先＞

J X 日鉱日石金属株式会社

電材加工事業本部 薄膜材料事業部

化合物半導体ユニット 主席技師

中村 正志

電話 03-5299-7286 Fax 03-5299-7349

e-mail : masashi\_nakamura@nmm.jx-group.co.jp